19p-A7-2

## RF 駆動による高速 FET センサ

Wide-bandwidth charge sensitivity with a radio-frequency field-effect transistor NTT 物性研<sup>1</sup>, Delft Univ. of Tech.<sup>2</sup> <sup>O</sup>西口克彦<sup>1</sup>, 山口浩司<sup>1</sup>, 藤原聡<sup>1</sup>, H. Zant<sup>2</sup>, G. Steele<sup>2</sup> NTT Basic Research Labs.<sup>1</sup>, Delft Univ. of Tech.<sup>2</sup> Katsuhiko Nishiguchi<sup>1</sup>, Hiroshi Yamaguchi<sup>1</sup>, Akira Fujiwara<sup>1</sup>, Herre van der Zant<sup>2</sup>, Gary Steele<sup>2</sup>

E-mail: nishiguchi.katsuhiko@lab.ntt.co.jp

[背景] 微細トランジスタ(FET)は高感度な電荷センサと して利用でき[1]、我々は、数十 nm のチャネルを持つ Si FET を用いて室温で単一電子を検出することに成功して いる(Fig. 1)[2]。しかし、微細 FET はチャネルが小さいた め抵抗が大きくなり、動作速度が数十 kHz 程度に限られ ていた。今回、我々はトランジスタに共振回路を接続し、 高周波信号の反射特性をモニタすることで動作速度を

20 MH まで改善することに成功した[3]。

[動作原理と結果] 単一電子を検出する FET はノンドープ SOI 基板から 作製する[2]。この FET にインダクタ L を接続すると FET の寄生容量  $C_s$ とで LC 共振回路が構成される[Fig. 2(a)]。回路の共振周波数  $1/(2\pi LC_s)$ に 近い周波数  $f_{carrier}$  の信号  $S_{carrier}$  を coulper を介して回路に印可すると、回路 の反射特性に応じた反射信号  $S_{ref}$  が得られる。この時、FET のゲート端 子に周波数が  $f_{gate}$ (=10 MHz)の信号  $S_{gate}$  を印可すると、FET のチャネル抵 抗とともに回路の反射特性が変調される。その結果、 $S_{ref}$ のスペクトラム 特性には、 $S_{carrier}$  に起因する信号の両脇に  $S_{gate}$  に起因する 2 つのサイド・ ピークが現れる[Fig. 2(b)]。今回、 $S_{gate}$  には単一電子信号に相当するパワ ーを印可しており、これらサイド・ピークの出現は  $S_{gate}$  に印可された単 一電子信号の検出を意味する。LC 共振回路は反射特性に応じて  $S_{carrier}$  を



Fig. 1:(a) An SEM image of an FET. (b) Singleelectron detection at room temperature.



一定期間蓄積することができるので、その範囲内で高速に  $S_{gate}$ を検出できる。また、同様の手法を用いる他の素子と比較し Si FET には数桁大きいパワーを印可することができるので、大きなサイド・ピーク信号が得られる。一方、サイド・ピークの周波数  $f_{carrier} \pm f_{gate}$  付近では、通常の測定で問題となる低周波数領域での 1/f ノイズを実質的に除去できるため S/N 特性が改善する。結果として、高速に微小な信号を検出することが可能となり、20 MHz で感度~10<sup>4</sup> e/Hz<sup>05</sup> という性能を室温で実現した。なお、 $S_{ref}$  と $S_{carrier}$ を考生サに入力することで、 $f_{carrier} \pm f_{gate}$  に現れるサイド・ピークを元の周波数  $f_{gate}$  に戻すことができ、任意の波形の  $S_{gate}$ を検出できる。これらの特徴により、室温で動作する高速・高感度なセンサとして幅広い利用が期待できる。

[謝辞] 本研究において有益なご助言を頂いた静岡大学・猪川洋教授に深く感謝いたします。本研究の一部 は最先端・次世代研究開発支援プログラムの助成を受けて行われた。

M. H. Devoret et al. Nature 406 (2000) 1039. [2] K. Nishiguchi et al. Jpn. J. Appl. Phys. 47 (2008) 8305. [3] K. Nishiguchi et al. Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 143102.